

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特開平03-080198	C30B 29/38 C30B 25/14 H01L 21/205		平01-213900	窒素化合物半導体単結晶膜の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
2	特開平04-164895	C30B 25/14 C30B 29/38 C30B 29/38 H01L 21/205		平02-288665	半導体結晶膜の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	13
3	特開平04-170390	C30B 25/16 C30B 29/38 // H01L 21/205		平02-296897	半導体結晶膜の成長方法および装置	徳 島	日亜化学工業株式会社	20
4	特開平04-247637	H01L 21/66 G01N 21/00 H01L 21/20		平03-035460	半導体結晶膜の表面状態測定方法		日亜化学工業株式会社	7
5	特開平04-284623	H01L 21/205 H01L 21/26		平03-074822	半導体結晶層の成長装置とその成長方法		日亜化学工業株式会社	6
6	特開平04-297023	H01L 21/205 H01L 33/00 // H01S 3/18		平03-089840	窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法		日亜化学工業株式会社	7
7	特開平04-321280	H01L 33/00 H01L 21/20 H01L 21/86		平03-116912	発光ダイオード		日亜化学工業株式会社	3
8	特開平05-063236	H01L 33/00		平04-034234	青色発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
9	特開平05-110138	H01L 33/00 H01L 21/205		平03-292303	窒化ガリウム系化合物半導体の結晶成長方法およびその素子。	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
10	特開平05-110139	H01L 33/00 H01L 21/203 H01L 21/205 H01S 3/18		平03-292304	窒化ガリウムアルミニウム半導体の結晶成長方法。	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
11	特開平05-152609	H01L 33/00		平03-336011	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
12	特開平05-166923	H01L 21/78 H01L 27/12 H01L 33/00		平03-352259	窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーの切断方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
13	特開平05-183189	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		平03-357046	p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
14	特開平05-198841	H01L 33/00		平04-032763	窒化ガリウム系化合物半導体のp型化方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
15	特開平05-206519	H01L 33/00 // H01S 3/18		平04-034133	窒化ガリウム系化合物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
16	特開平05-206520	H01L 33/00 H01L 21/477		平04-040280	p型III-V族化合物半導体の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
17	特開平05-291621	H01L 33/00		平04-118227	窒化ガリウム系化合物半導体の電極材料	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
18	特開平05-343742	H01L 33/00 H01L 21/78		平04-172042	窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
19	特開平06-120562	H01L 33/00		平04-289495	青色発光デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
20	特開平06-177059	H01L 21/205 H01L 21/268 H01L 33/00 H01S 3/18		平04-352944	窒化インジウムガリウムの成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
21	特開平06-177423	H01L 33/00		平05-114541	青色発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
22	特開平06-177429	H01L 33/00		平04-351948	青色LED素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
23	特開平06-177434	H01L 33/00 H01L 23/29 H01L 23/31 H01L 23/29 H01L 23/31		平04-351947	青色発光素子及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
24	特開平06-196755	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-106554	窒化インジウムガリウム半導体およびその成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
25	特開平06-196757	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 29/205		平05-106555	窒化インジウムガリウム半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
26	特開平06-209120	H01L 33/00		平05-114542	青色発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
27	特開平06-209121	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-106556	窒化インジウムガリウム 半導体およびその成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
28	特開平06-209122	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-106557	窒化インジウムガリウム 半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
29	特開平06-216409	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 3/18		平05-022085	窒化物半導体単結晶層の 成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
30	特開平06-232450	H01L 33/00		平05-039359	窒化ガリウム系化合物半 導体及びその電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
31	特開平06-232451	H01L 33/00 H01L 21/205		平05-042125	p型窒化ガリウムの成長 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
32	特開平06-232510	H01S 3/18 H01L 23/36 H01L 33/00		平05-042126	半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
33	特開平06-237012	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-045983	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
34	特開平06-244458	H01L 33/00		平05-055074	青色発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
35	特開平06-260680	H01L 33/00		平05-070873	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
36	特開平06-260681	H01L 33/00		平05-070874	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
37	特開平06-260682	H01L 33/00		平05-114543	青色発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
38	特開平06-260683	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-114544	青色発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
39	特開平06-268257	H01L 33/00		平05-079045	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
40	特開平06-268259	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-079046	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
41	特開平06-275867	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 3/18	301	平05-085491	窒化ガリウム系化合物半 導体のp型化方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
42	特開平06-275868	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-085492	窒化ガリウム系化合物半 導体の電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
43	特開平06-283758	H01L 33/00 H01L 21/304 H01L 21/78 H01S 3/18		平05-092403	窒化ガリウム系化合物半 導体ウエハーの切断方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
44	特開平06-291366	H01L 33/00		平05-098621	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
45	特開平06-291368	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-100215	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子及びその製 造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
46	特開平06-296041	H01L 33/00		平05-107664	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
47	特開平06-302864	H01L 33/00		平05-109985	発光デバイスの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
48	特開平06-314821	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		平05-124889	窒化ガリウム系化合物半 導体のp型化方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
49	特開平06-314822	H01L 33/00 G02F 1/1343 H01L 21/324		平05-124890	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子及びその電 極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
50	特開平06-338632	H01L 33/00		平05-129313	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
51	特開平07-007182	H01L 33/00		平05-146383	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
52	特開平07-015041	H01L 33/00		平05-157219	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
53	特開平07-015044	H01L 33/00		平05-157218	多色発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
54	特開平07-045867	H01L 33/00		平05-207274	n型窒化ガリウム系化合 物半導体層の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	5

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
55	特開平07-086640	H01L 33/00 H01L 21/52		平05-263783	発光デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
56	特開平07-094782	H01L 33/00 H01L 21/324		平05-234684	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
57	特開平07-094783	H01L 33/00 H01L 29/40		平05-234685	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
58	特開平07-099345	H01L 33/00 H01L 23/29 H01L 23/31 H01L 23/29 H01L 23/31		平05-241449	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
59	特開平07-106633	H01L 33/00		平05-253171	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
60	特開平07-122520	H01L 21/301 H01L 33/00		平05-263782	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
61	特開平07-131069	H01L 33/00 H01L 21/301 H01L 21/86		平05-300940	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
62	特開平07-142763	H01L 33/00 H01L 21/301 H01S 3/18		平05-288365	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
63	特開平07-162038	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-310533	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
64	特開平07-169715	H01L 21/301 H01L 33/00		平05-279546	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
65	特開平07-176826	H01S 3/18 H01L 33/00		平05-318275	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
66	特開平07-183576	H01L 33/00 H01S 3/18		平05-327762	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
67	特開平07-221103	H01L 21/321 H01L 33/00 H01S 3/18		平06-008727	n型窒化ガリウム系化合 物半導体層の電極及びそ の形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
68	特開平07-221347	H01L 33/00 H01L 27/12 H01S 3/18		平06-014569	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
69	特開平07-235558	H01L 21/52 H01L 33/00		平06-022672	L E Dチップのリードフ レームへのダイボンド方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
70	特開平07-235729	H01S 3/18 H01L 33/00		平06-022671	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
71	特開平07-254733	H01L 33/00 H01S 3/18		平06-302586	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子およびその 電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
72	特開平07-273069	H01L 21/301		平06-062229	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
73	特開平07-288334	H01L 31/10 H01L 31/04		平06-078294	窒化ガリウム系化合物半 導体受光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
74	特開平07-312350	H01L 21/205 C23C 16/18 H01L 33/00 // H01S 3/18		平07-152676	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
75	特開平07-335975	H01S 3/18		平06-131530	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
76	特開平08-023124	H01L 33/00 H01S 3/18		平06-154708	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
77	特開平08-070139	H01L 33/00 H01S 3/18		平06-227679	n型窒化ガリウム系化合 物半導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
78	特開平08-088441	H01S 3/18 H01L 33/00		平06-222920	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子及びその 製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
79	特開平08-130327	H01L 33/00		平06-269279	I I I - V族窒化物半導 体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
80	特開平08-148717	H01L 33/00		平06-280732	青色発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	5

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
81	特開平08-153931	H01S 3/18		平06-295433	窒化ガリウム系化合物半 導体レーザ素子の製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
82	特開平08-162671	H01L 33/00		平07-229080	窒化物半導体発光ダイオ ード	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
83	特開平08-191171	H01S 3/18 H01L 33/00		平07-003033	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
84	特開平08-213656	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		平07-310804	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
85	特開平08-213694	H01S 3/18		平07-020420	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
86	特開平08-228025	H01L 33/00 H01S 3/18		平07-322924	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
87	特開平08-228048	H01S 3/18 H01L 33/00		平07-317845	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
88	特開平08-264891	H01S 3/18		平07-317847	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
89	特開平08-274414	H01S 3/18 H01L 33/00		平07-317846	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
90	特開平08-316528	H01L 33/00 H01S 3/18		平07-314339	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
91	特開平08-330630	H01L 33/00 H01S 3/18		平07-317848	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
92	特開平08-335719	H01L 33/00		平07-140967	窒化物半導体発光ダイオ ード	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
93	特開平08-335720	H01L 33/00 H01L 23/18 H01L 23/29 H01L 23/31		平07-140966	窒化物半導体発光ダイオ ード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
94	特開平08-340131	H01L 33/00 H01L 29/41		平08-181595	窒化ガリウム系化合物半 導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
95	特開平09-008351	H01L 33/00		平07-157256	n型窒化物半導体層の電 極	徳 島	日亜化学工業株式会社	8

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
96	特開平09-008403	H01S 3/18 H01L 21/02 H01L 33/00		平07-148470	窒化物半導体素子の製造 方法及び窒化物半導体素 子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
97	特開平09-036430	H01L 33/00 H01S 3/18		平08-036250	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	26
98	特開平09-069623	H01L 29/43 H01L 31/10 H01L 33/00 H01S 3/18		平07-224913	n型窒化物半導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
99	特開平09-083016	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 3/18		平07-237501	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
100	特開平09-107125	H01L 33/00 H01S 3/18		平08-267857	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
101	特開平09-116232	H01S 3/18 H01L 33/00		平07-275220	窒化物半導体レーザ素子 及びその共振器の作製方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
102	特開平09-129919	H01L 33/00 H01L 21/203		平07-279967	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
103	特開平09-129931	H01L 33/00 H01S 3/18		平08-267856	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
104	特開平09-129932	H01L 33/00		平07-281170	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
105	特開平09-148247	H01L 21/20 H01L 21/203 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 3/18		平07-305279	n型窒化物半導体の成長 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
106	特開平09-148678	H01S 3/18 H01L 33/00		平07-305281	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
107	特開平09-153642	H01L 33/00		平07-317849	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
108	特開平09-162444	H01L 33/00		平07-321755	窒化物半導体多色発光素 子及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
109	特開平09-181394	H01S 3/18 H01L 21/60 H01S 3/043	311	平07-337599	窒化物半導体レーザダイ オード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
110	特開平09-199798	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-006298	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
111	特開平09-214044	H01S 3/18		平08-012797	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
112	特開平09-214051	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-012796	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
113	特開平09-214055	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-018707	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
114	特開平09-219556	H01S 3/18		平07-332056	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
115	特開平09-219560	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-006300	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
116	特開平09-223846	H01S 3/18 H01S 3/043		平08-028840	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
117	特開平09-232676	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-032154	窒化物半導体レーザ素子 およびその共振面の作製 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
118	特開平09-237932	H01S 3/18		平08-041793	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
119	特開平09-246651	H01S 3/18		平08-053428	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
120	特開平09-246666	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-053429	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
121	特開平09-260771	H01S 3/18		平08-067631	窒化物半導体レーザ素子 およびその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
122	特開平09-260772	H01S 3/18		平08-067632	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
123	特開平09-275243	H01S 3/18 H01L 27/12 H01L 33/00	平08-083446	窒化物半導体の結晶成長 方法およびレーザ素子の 共振面の形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6	
124	特開平09-283854	H01S 3/18 H01L 33/00	平08-095161	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7	

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
125	特開平09-293898	H01L 33/00 H01S 3/18		平08-102542	窒化物半導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
126	特開平09-298311	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平08-354406	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
127	特開平09-307193	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-124154	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
128	特開平09-321381	H01S 3/18		平08-136095	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
129	特開平09-331116	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-181573	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
130	特開平10-004235	H01S 3/18		平08-155370	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
131	特開平10-012969	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-157812	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
132	特開平10-041581	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-149183	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
133	特開平10-056208	H01L 33/00 G09F 9/00 H01L 21/56 H01L 23/28 H01L 23/29 (以下省略)	336	平09-143158	発光ダイオードの製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
134	特開平10-065221	H01L 33/00 H01L 23/29 H01L 23/31 H01L 23/29 H01L 23/31 (以下省略)		平09-143157	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
135	特開平10-075008	H01S 3/18		平08-229161	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
136	特開平10-084134	H01L 33/00 H01S 3/18		平09-286732	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
137	特開平10-084135	H01L 33/00	103	平09-277251	n型窒化ガリウム系化合物半導体の電極及びその形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
138	特開平10-091091	G09F 9/33 H01L 33/00 H04N 5/66		平09-143159	発光ダイオードを用いたディスプレイ	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
139	特開平10-093138	H01L 33/00		平09-294191	窒化物半導体発光ダイオードを備えた表示装置	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
140	特開平10-093146	H01L 33/00		平09-306393	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
141	特開平10-093186	H01S 3/18		平08-244701	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
142	特開平10-117016	H01L 33/00 H01S 3/18		平08-270375	窒化物半導体素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
143	特開平10-117017	H01L 33/00		平09-330959	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
144	特開平10-125958	H01L 33/00 H01L 21/301 H01L 21/86 H01S 3/18		平09-306394	窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
145	特開平10-126006	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-290218	窒化物半導体デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
146	特開平10-135516	H01L 33/00 H01L 21/205		平09-332546	半導体積層構造	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
147	特開平10-135570	H01S 3/18 // H01L 33/00		平08-284933	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
148	特開平10-144960	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324 H01S 3/18		平08-296872	p型窒化物半導体の製造方法及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
149	特開平10-145000	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-294711	窒化物半導体素子及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
150	特開平10-145002	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-304259	窒化物半導体素子及び窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
151	特開平10-154829	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324 H01L 31/04		平08-313442	p型窒化物半導体の成長 方法及び窒化物半導体素 子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
152	特開平10-163530	H01L 33/00 H01L 31/10 H01S 3/18		平08-315816	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
153	特開平10-163571	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-319067	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
154	特開平10-173231	H01L 33/00 H01S 3/18		平10-002546	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
155	特開平10-173282	H01S 3/18		平08-333884	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
156	特開平10-178204	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098491	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
157	特開平10-178205	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098492	窒化ガリウム系化合物半 導体をp型化する方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
158	特開平10-178206	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098493	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
159	特開平10-178207	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098494	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
160	特開平10-178208	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098495	窒化ガリウム系化合物半 導体をp型化する方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
161	特開平10-178209	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098496	窒化ガリウム系化合物半 導体	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
162	特開平10-178210	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098497	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
163	特開平10-178211	H01L 33/00 H01L 21/324 H01L 27/12 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098498	窒化ガリウム系化合物半 導体を p 型化する方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
164	特開平10-178212	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098499	窒化ガリウム系化合物半 導体とこの半導体を使用 した発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
165	特開平10-178213	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 3/18 // H01L 21/205		平09-098500	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
166	特開平10-178239	H01S 3/18 H01L 33/00 // H01L 21/02		平08-336694	窒化物半導体素子の製造 方法及び窒化物半導体素 子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
167	特開平10-190149	H01S 3/18 H01L 33/00		平08-349418	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
168	特開平10-215029	H01S 3/18 H01L 31/04 H01L 31/0264 H01L 33/00		平09-015171	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
169	特開平10-223983	H01S 3/18 H01L 31/04 H01L 31/0264 H01L 33/00		平09-021557	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
170	特開平10-229218	H01L 33/00 H01L 21/02 // H01L 21/205		平09-031734	窒化物半導体基板の製造 方法および窒化物半導体 基板	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
171	特開平10-233549	H01S 3/18		平09-036791	窒化物半導体レーザダイ オード	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
172	特開平10-242581	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-044176	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
173	特開平10-242587	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-056870	窒化物半導体素子及び半 導体レーザダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
174	特開平10-256661	H01S 3/18 H01L 31/04 H01L 31/10 H01L 33/00		平09-056046	窒化物半導体素子及びそ の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
175	特開平10-256662	H01S 3/18 H01L 33/00 // H01L 21/02 H01L 21/205		平09-056047	窒化物半導体基板の製造 方法及び窒化物半導体素 子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
176	特開平10-270755	H01L 33/00 H01S 3/18		平09-069879	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
177	特開平10-270757	H01L 33/00 H01L 21/28	301	平10-099585	窒化ガリウム系化合物半 導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
178	特開平10-284801	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-086536	窒化物半導体レーザダイ オード	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
179	特開平10-290047	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-051232	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
180	特開平10-294492	H01L 33/00 H01L 21/205 // H01S 3/18		平10-029224	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
181	特開平10-303493	H01S 3/18		平09-106873	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
182	特開平10-308558	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-116613	窒化物半導体レーザ素子 及び窒化物半導体レーザ 素子の製造方法。	徳 島	日亜化学工業株式会社	6

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
183	特開平10-326943	H01S 3/18 H01L 33/00	301	平09-285404	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
184	特開平10-335705	H01L 33/00 H01S 3/18		平09-138228	窒化ガリウム系化合物半 導体素子及びその製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
185	特開平10-335757	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-364012	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	20
186	特開平11-004039	H01S 3/18		平09-153814	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
187	特開平11-004048	H01S 3/18 H01L 21/301 H01L 31/10 H01L 33/00		平10-050859	窒化物半導体素子及び窒 化物半導体素子の製造方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
188	特開平11-008410	H01L 33/00 H01L 21/28 H01S 3/18		平09-160726	n型窒化物半導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
189	特開平11-008439	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-159341	窒化物半導体発光素子お よびその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
190	特開平11-031841	H01L 33/00 H01S 3/18		平09-187070	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
191	特開平11-046038	H01S 3/18		平09-285405	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
192	特開平11-068155	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 31/04 H01L 31/10		平09-151800	窒化物半導体素子及び窒 化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
193	特開平11-074562	H01L 33/00 H01L 29/20 H01L 31/04 H01L 31/10 H01S 3/18		平09-285406	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
194	特開平11-074615	H01S 3/18 H01L 33/00		平09-232349	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
195	特開平11-112109	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-227609	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
196	特開平11-163405	H01L 33/00 H01L 21/301		平10-279386	窒化ガリウム系化合物半 導体チップ	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
197	特開平11-177175	H01S 3/18		平09-311272	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	20
198	特開平11-186659	H01S 3/18 // H01L 33/00		平09-352540	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
199	特開平11-191533	H01L 21/205		平10-052993	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
200	特開平11-191637	H01L 33/00 H01S 3/18		平10-126989	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
201	特開平11-191638	H01L 33/00 H01S 3/18		平10-128409	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	12
202	特開平11-191639	H01L 33/00 H01S 3/18		平10-176623	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
203	特開平11-191657	H01S 3/18 H01L 21/205		平10-077245	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	20
204	特開平11-191658	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-127997	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	13
205	特開平11-195812	H01L 33/00 H01S 3/18		平09-348972	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
206	特開平11-195840	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-000614	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
207	特開平11-204882	H01S 3/18		平10-008244	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
208	特開平11-214744	H01L 33/00		平10-013867	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
209	特開平11-214746	H01L 33/00 H01S 3/18		平09-348973	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
210	特開平11-214798	H01S 3/18 H01L 21/205 H01L 33/00		平10-011590	窒化物半導体素子の製造 方法及び窒化物半導体素 子	徳 島	日亜化学工業株式会社	12

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
211	特開平11-219909	H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 3/18		平10-131618	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
212	特開平11-219910	H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 3/18		平10-132831	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
213	特開平11-220172	H01L 33/00 H01S 3/18	673	平10-326404	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
214	特開平11-220173	H01L 33/00 H01S 3/18	673	平10-329384	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
215	特開平11-220174	H01L 33/00 H01S 3/18	673	平10-330858	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
216	特開平11-224971	H01S 3/18	673	平10-335425	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
217	特開平11-224972	H01S 3/18 H01L 33/00	673	平10-337197	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
218	特開平11-238692	H01L 21/26 H01L 21/268 H01L 33/00 H01S 3/18		平10-039462	窒化物半導体の低抵抗化 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
219	特開平11-238945	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-151393	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
220	特開平11-243227	H01L 33/00		平10-369501	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
221	特開平11-251253	H01L 21/205 H01L 31/02 H01L 33/00 H01S 3/18		平10-052573	窒化物半導体基板の製造 方法および窒化物半導体 基板	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
222	特開平11-251631	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 3/18		平10-049906	窒化物半導体素子及びそ の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	12
223	特開平11-251684	H01S 3/18 H01L 33/00 // H01L 21/205		平10-045665	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
224	特開平11-261108	H01L 33/00 H01S 3/18	673	平11-009276	表示装置	徳 島	日亜化学工業株式会社	27
225	特開平11-261114	H01L 33/00		平10-377128	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
226	特開平11-266034	H01L 33/00 H01S 3/18		平10-067553	窒化物半導体基板および 窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
227	特開平11-298090	H01S 3/18 H01L 21/205 H01L 31/10 H01L 33/00		平10-097134	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
228	特開平11-312841	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-117685	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
229	特開平11-330552	H01L 33/00 H01S 3/18		平10-134823	窒化物半導体発光素子及 び発光装置	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
230	特開平11-330610	H01S 3/18 // H01L 33/00		平10-127972	窒化物半導体レーザー	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
231	特開平11-330614	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-129810	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
232	特開平11-330621	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-139495	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
233	特開平11-330622	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-139496	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
234	特開平11-340508	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 3/18		平10-146431	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	12
235	特開平11-340571	H01S 3/18 H01L 33/00		平10-144502	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
236	特開2000-004063	H01S 5/30		平10-126549	窒化物半導体レーザ素子 及びその電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
237	特開2000-004066	H01S 5/30		平10-168872	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
238	特開2000-012956	H01S 5/30		平10-173643	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
239	特開2000-031601	H01S 5/30 H01L 33/00		平10-199964	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
240	特開2000-068594	H01S 5/30 H01L 33/00		平10-199829	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	13
241	特開2000-091635	H01L 33/00		平11-300983	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
242	特開2000-101193	H01S 5/323 H01L 33/00		平10-267759	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
243	特開2000-156348	H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/343		平10-278308	窒化物半導体基板及びそ れを用いた窒化物半導体 素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
244	特開2000-174392	H01S 5/323 H01L 33/00		平10-345022	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
245	特開2000-183462	H01S 5/323		平10-355187	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
246	特開2000-188423	H01L 33/00 H01S 5/323		2000-039758	窒化物半導体素子の形成 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
247	特開2000-196199	H01S 5/343 // H01L 33/00		平10-367945	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
248	特開2000-196201	H01S 5/343 H01L 33/00		平11-254362	窒化物半導体レ ザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
249	特開2000-236142	H01S 5/343 // H01L 33/00		平11-279913	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
250	特開2000-244061	H01S 5/223 H01S 5/323 H01L 21/203 H01L 21/205 H01L 33/00		平11-037827	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
251	特開2000-277804	H01L 33/00 H01L 31/10 H01S 5/042 H01S 5/323	610	2000-067673	窒化物半導体素子の製造 方法及び窒化物半導体素 子、並びに発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
252	特開2000-294875	H01S 5/22 H01S 5/323	610	平11-095129	窒化物レーザ素子構造	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
253	特開2000-299497	H01L 33/00 H01L 21/20 H01S 5/343 // H01L 21/205		平11-331797	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
254	特開2000-299532	H01S 5/343 H01L 33/00		平11-256452	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
255	特開2000-315814	H01L 31/12 G11B 7/125 G11B 7/13 H01L 27/15 H01L 31/10 (以下省略)		平11-124134	窒化ガリウム系ハイブリッド素子及びその作製方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
256	特開2001-007444	H01S 5/323		2000-158368	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
257	特開2001-028473	H01S 5/343 H01L 21/205 H01L 33/00		2000-184901	n型窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
258	特開2001-044514	H01L 33/00		2000-215236	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
259	特開2001-044570	H01S 5/343		平11-212851	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	16
260	特開2001-057447	H01L 33/00 H01L 23/29 H01L 23/31 H01L 23/29 H01L 23/31		2000-215237	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
261	特開2001-057460	H01S 5/22 H01S 5/323		2000-099796	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	16
262	特開2001-057461	H01S 5/22 H01S 5/343		2000-099797	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	17
263	特開2001-060740	H01S 5/22 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/343		2000-222080	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
264	特開2001-077469	H01S 5/22 H01S 5/323		2000-281097	窒化物半導体レーザ素子の形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
265	特開2001-119069	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/343		2000-309753	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	24
266	特開2001-126991	H01L 21/205 C30B 29/40 H01S 5/323	502	平11-301585	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
267	特開2001-156332	H01L 33/00 H01L 21/301 H01S 5/02 H01S 5/323		2000-304615	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
268	特開2001-168471	H01S 5/343 H01L 33/00		平11-308964	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	13
269	特開2001-168473	H01S 5/343 H01L 33/00		2000-330288	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
270	特開2001-203389	H01L 33/00 H01S 5/042	610	2000-381850	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子およびその 電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
271	特開2001-210905	H01S 5/02 H01L 33/00		2000-393193	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
272	特開2001-284645	H01L 33/00 H01S 5/323	610	2000-384363	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
273	特開2001-320130	H01S 5/22		2001-136621	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
274	特開2002-033514	H01L 33/00 H01S 5/343	610	2001-152543	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
275	特開2002-053399	C30B 29/38 H01L 21/02 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/323	610	2001-149892	窒化物半導体基板の製造 方法および窒化物半導体 基板	徳 島	日亜化学工業株式会社	4
276	特開2002-057369	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323	610	2001-171341	発光デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	7

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
277	特開2002-084035	H01S 5/223 H01S 5/323		2001-273293	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
278	特開2002-084043	H01S 5/343	610	2001-230551	窒化物半導体デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
279	特開2002-084045	H01S 5/343 H01L 21/205 H01L 33/00	610	2001-206460	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
280	特開2002-134839	H01S 5/323 H01S 5/223	610	2001-273286	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
281	特開2002-141553	H01L 33/00 H01S 5/343	610	2001-282288	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	28
282	特開2002-151797	H01S 5/343 H01L 21/20	610	2001-233486	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
283	特開2002-151798	H01S 5/343 H01L 33/00	610	2001-281328	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
284	特開2002-154900	C30B 29/38 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/323	610	2001-266561	窒化ガリウム系化合物半 導体の結晶成長方法と窒 化ガリウム系化合物半導 体	徳 島	日亜化学工業株式会社	13
285	特開2002-158378	H01L 33/00		2001-313286	発光ダイオード	徳 島	日亜化学工業株式会社	3
286	特開2002-164572	H01L 33/00 H01S 5/323	610	2001-319394	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
287	特開2002-164573	H01L 33/00 H01S 5/323	610	2001-319395	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
288	特開2002-171024	H01S 5/028 H01S 5/02 H01S 5/323	610	2001-361772	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
289	特開2002-171025	H01S 5/042 H01L 21/28 H01L 33/00 H01S 5/323	612 301 610	2001-341208	n型窒化物半導体の電極	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
290	特開2002-185044	H01L 33/00		2001-361771	窒化物半導体多色発光素 子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
291	特開2002-208756	H01S 5/323	610	2001-381604	窒化物半導体レーザダイ オードとその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
292	特開2002-237658	H01S 5/323 H01L 21/205 H01L 33/00	610	2001-375704	窒化インジウムガリウム 半導体およびその成長方 法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
293	特開2002-252409	H01S 5/028 H01S 5/323	610	2002-040228	窒化物半導体レーザ素子 及びその製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
294	特開2002-261014	H01L 21/20 C30B 29/38 H01L 21/205 H01L 33/00	610	2001-363030	窒化物半導体素子の製造 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
295	特開2002-270962	H01S 5/22 H01S 5/028 H01S 5/323	610	2002-017613	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
296	特開2002-270968	H01S 5/323	610	2002-034969	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
297	特開2002-289972	H01S 5/227 H01S 5/323	610	2002-006460	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
298	特開2002-305325	H01L 33/00 H01L 21/324 H01S 5/323	610	2002-040852	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
299	特開2002-324914	H01L 33/00 H01L 21/205 H01S 5/323	610	2002-034089	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
300	特開2002-329886	H01L 33/00 H01S 5/323	610	2002-118852	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
301	特開2002-374041	H01S 5/223 H01L 21/205 H01S 5/323	610	2002-154620	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
302	特開2002-374044	H01S 5/343	610	2002-170623	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
303	特開2003-017746	H01L 33/00 H01S 5/343	610	2002-128255	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	20

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
304	特開2003-017792	H01S 5/02 H01S 5/343	610	2002-170643	窒化物半導体レーザ素子 およびその共振面の作製 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
305	特開2003-046203	H01S 5/343 H01L 21/205 H01L 33/00	610	2002-156016	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
306	特開2003-078163	H01L 33/00		2002-244428	窒化物半導体の成長方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
307	特開2003-078164	H01L 33/00		2002-245672	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
308	特開2003-101154	H01S 5/343	610	2002-260153	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	20
309	特開2003-101159	H01S 5/343 H01L 21/205 H01L 21/316 H01L 21/318 H01L 33/00 (以下省略)	610	2002-229368	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
310	特開2003-101160	H01S 5/343 H01L 33/00	610	2002-268261	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	21
311	特開2003-115641	H01S 5/343	610	2002-262516	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	14
312	特開2003-133634	H01S 5/042 H01S 5/223 H01S 5/323	612 610	2002-240432	窒化物半導体レーザ素子 の電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
313	特開2003-142769	H01S 5/042 H01S 5/22 H01S 5/343	612 610	2002-240433	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	10
314	特開2003-152266	H01S 5/042 H01S 5/323	612 610	2002-334433	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
315	特開2003-163415	H01S 5/223		2002-354976	窒化物半導体発光素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
316	特開2003-234513	H01L 33/00		2003-067318	蛍光染料又は蛍光顔料が 添加された波長変換発光 ダイオード用樹脂	徳 島	日亜化学工業株式会社	3

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
317	特開2003-238297	C30B 29/38 C30B 25/18 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/343	610	2002-373146	窒化物半導体基板及びそ れを用いた窒化物半導体 素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	11
318	特開2003-249463	H01L 21/28 H01L 21/28 H01L 33/00 H01S 5/323	301 610	2002-371821	窒化物半導体基板の製造 方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
319	特開2003-257880	H01L 21/205 H01L 33/00		2003-080001	発光デバイス	徳 島	日亜化学工業株式会社	7
320	特開2003-264315	H01L 33/00 H01L 21/28 // H01L 21/3065	301	2003-006334	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子およびその 電極形成方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
321	特開2003-264343	H01S 5/227 H01S 5/323	610	2003-102713	窒化物半導体レーザ素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	15
322	特開2003-309290	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		2003-064147	窒化ガリウム系化合物半 導体	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
323	特開2003-318494	H01S 5/323 H01L 21/205	610	2003-108767	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	9
324	特開2003-338638	H01L 33/00 H01S 5/02		2003-137162	窒化ガリウム系化合物半 導体チップの製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	5
325	特開2003-347592	H01L 33/00 H01L 21/205		2003-171428	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子の製造方法	徳 島	日亜化学工業株式会社	6
326	特開2003-347681	H01S 5/343	610	2003-179030	窒化物半導体素子	徳 島	日亜化学工業株式会社	8
327	特開2004-006886	H01L 21/205 H01S 5/343	610	2003-148359	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	13
328	特開2004-006913	H01S 5/028 H01S 5/323	610	2003-163543	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10
329	特開2004-006919	H01L 33/00 H01S 5/042 H01S 5/323	612 610	2003-170766	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
330	特開2004-015072	H01L 33/00 H01S 5/343	610	2003-334578	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	7
331	特開2004-031990	H01L 33/00 H01S 5/343	610	2003-355406	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	36
332	特開2004-048057	H01L 21/205 C23C 16/34 C30B 29/38 H01L 33/00 H01S 5/323	610	2003-331721	窒化インジウムガリウム 半導体の成長方法	徳島	日亜化学工業株式会社	8
333	特開2004-096129	H01L 33/00 H01L 21/205		2003-393145	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
334	特開2004-104088	H01S 5/343	610	2003-184397	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
335	特開2004-146854	H01S 5/343 H01S 5/022 H01S 5/22	610	2004-042161	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
336	特開2004-158872	H01L 33/00 H01L 21/301		2004-010750	発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	8
337	特開2004-158873	H01L 33/00		2004-011214	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
338	特開2004-158874	H01L 33/00		2004-011215	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
339	特開2004-158887	H01S 5/343 H01S 5/22	610	2004-042159	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	11
340	特開2004-165693	H01S 5/343	610	2004-005696	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	14
341	特開2004-214698	H01S 5/343 H01L 33/00	610	2004-096500	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	15
342	特開2004-253817	H01L 21/205 C30B 29/38 H01L 33/00		2004-139815	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	56
343	特開2004-266293	H01L 33/00		2004-169261	窒化ガリウム系化合物半 導体	徳島	日亜化学工業株式会社	13
344	特開2004-289183	H01S 5/343	610	2004-204862	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	16
345	特開2004-297098	H01S 5/343	610	2004-211928	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	19

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
346	特開2004-343132	H01L 33/00 H01L 21/205 H01L 21/324		2004-169260	窒化ガリウム系化合物半 導体の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	13
347	特開2004-363635	H01L 33/00		2004-280288	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
348	特開2005-020034	H01S 5/323	610	2004-302800	窒化物半導体の成長方法 及び窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	19
349	特開2005-136446	H01S 5/343 H01L 33/00	610	2005-042522	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	20
350	特開2005-167282	H01S 5/343 H01L 21/205	610	2005-054879	窒化物半導体素子及びそ の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	16
351	特開2005-252311	H01L 33/00		2005-158166	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
352	特開2005-252312	H01L 33/00		2005-158167	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
353	特開2005-311396	H01L 33/00		2005-209226	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
354	特開2005-317995	H01L 33/00		2005-209227	窒化ガリウム系化合物半 導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	10

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特表2005-522888	H01S 5/343 H01L 21/205 H01L 33/00	610	2003-586401	非極性 (Al, B, In, Ga) N量子井戸、ならびにヘテロ構造材料およびデバイス	米国	ザ リージェント オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア	18

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特開2006-060254	H01L 33/00		2005-317711	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
2	特開2006-179959	H01S 5/343		2006-083230	窒化物半導体発光素子	徳島	日亜化学工業株式会社	11
3	特開2006-222463	H01L 33/00		2006-141977	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
4	特開2006-279082	H01L 33/00		2006-189777	窒化物半導体発光素子の 製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	17

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特表2006-510227	H01L 21/205 H01L 21/02		2004-564676	ハイドライド気相成長法による転位密度の低い無極性窒化ガリウムの成長	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	21
2	特表2006-514780	H01L 21/205 H01L 29/201 H01L 21/20 C23C 16/34 C30B 29/38		2004-564675	ハイドライド気相成長法による平坦な無極性 a 面窒化ガリウムの成長	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	26

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特開2007-067454	H01L 33/00 H01S 5/042 H01S 5/323		2006-333737	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	34
2	特開2007-184655	H01L 33/00		2007-102120	発光ダイオード	徳島	日亜化学工業株式会社	4
3	特開2007-214604	H01S 5/00 H01S 5/343		2007-140655	窒化物半導体レーザ素子 の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	9
4	特開2007-294982	H01S 5/183 H01S 5/343		2007-151951	窒化物半導体レーザ素子	徳島	日亜化学工業株式会社	16

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特表2007-521641	H01L 33/00 H01L 21/306		2005-512858	表面粗化による高効率の (B , A l , G a , I n) Nベースの発光ダイオ ード	米国 埼玉	ザ・レジェンツ・オブ・ザ ・ユニバーシティ・オブ・ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	20

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特開2008-034862	H01L 21/205 C30B 29/38 C30B 25/04 H01L 33/00 H01S 5/343		2007-219841	窒化物半導体の成長方法	徳島	日亜化学工業株式会社	33
2	特開2008-166835	H01S 5/343 H01L 21/205		2008-023805	窒化物半導体レーザ素子の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	12
3	特開2008-288572	H01L 21/20 C30B 29/38 H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/22 (以下省略)		2008-098853	窒化物半導体素子の製造方法	徳島	日亜化学工業株式会社	16

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発明の名称	出願人		全頁
						都府県 国籍等	氏名 (名称)	
1	特表2008-501606	C30B 29/38 C30B 25/20 C23C 16/34 H01L 21/205 H01L 33/00 (以下省略)		2007-515412	ハイドライド気相成長法による平坦で低転位密度のm面窒化ガリウムの成長	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	30
2	特表2008-533723	H01L 21/205 H01L 33/00		2008-500965	平坦な半極性窒化ガリウムの成長技術	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	18
3	特表2008-543087	H01L 21/205		2008-514783	有機金属化学気相成長法 (MOCVD) による平坦な無極性 { 1 - 1 0 0 } m面窒化ガリウムの成長方法及び装置	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	14
4	特表2008-543089	H01L 21/205 H01L 33/00 H01S 5/343		2008-514810	半極性 (Ga, Al, In, B) N薄膜、ヘテロ構造およびデバイスの成長と作製のための方法及び装置	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	31
5	特表2008-544552	H01L 33/00		2008-518342	偏光発光ダイオードの作製に関するパッケージ技術	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	18

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特開2009-027201	H01S 5/22		2008-283153	窒化物半導体素子	徳島	日亜化学工業株式会社	32

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特表2009-500284	C30B 29/38 C30B 7/10 //H01S 5/323 H01L 33/00		2008-520225	耐圧釜を用いた超臨界ア ンモニア中での I I I 族 窒化物結晶の成長方法	米国 埼玉	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 独立行政法人科学技術振興 機構	17

No	公報番号	国際分類 (Int.Cl.)	識別 記号	出願番号	発 明 の 名 称	出 願 人		全頁
						都府県 国籍等	氏 名 (名称)	
1	特開2010-135845	H01S 5/343 H01L 33/32 H01L 21/205		2010-044770	非極性 (Al , B , In , Ga) N量子井戸、ならびにヘテロ構造材料およびデバイス	米国	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア	14
2	特開2011-040789	H01L 21/205 H01S 5/343		2010-250340	非極性 (Al , B , In , Ga) N量子井戸、ならびにヘテロ構造材料およびデバイス	米国	ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア	12